Best Available Copy PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-220372

(43)Date of publication of application: 10.08.1999

(51)Int.Cl.

H03K 17/945 H03B 5/12 H03K 17/95

(21)Application number: 10-019433

(71)Applicant: YAMATAKE CORP

(22)Date of filing:

30.01.1998

(72)Inventor: FURUSHIMA HIROAKI

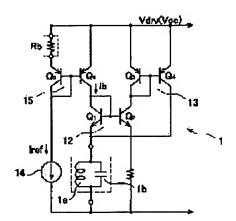
KAWAI SHINICHI

(54) PROXIMITY SWITCHING DEVICE OF HIGH-FREQUENCY OSCILLATION TYPE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain low current consumption by constituting a bias current supplying circuit to a transistor circuit of a current mirror circuit driven by a constant current source and inserting a resistor controlling the output current of the current mirror circuit to the current mirror circuit so as to easily set an optimum bias current according to an oscillation frequency.

SOLUTION: A current Iref from the constant current source 14 is temporarily received by a third current mirror circuit 15 and its output current is supplied for a first current mirror circuit 12 to easily adjust the bias current Ib of a transistor Q1 by the resistor Rb assembled to the circuit 15 while keeping the current Iref outputted from the source 14 to be constant. Consequently, the bias current Ib is easily adjusted by differentiating the value of the resistor Rb according to the specification of an oscillation frequency and low current consumption is attained without supplying excessive bias current Ib.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3436342

[Date of registration]

06.06.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-220372

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

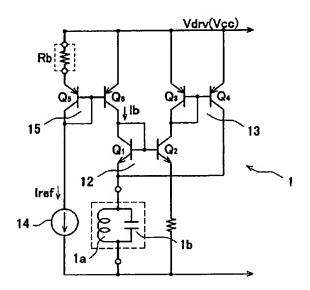
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ					
нозк	17/945		H03K 1	7/945]	В		
H03B	5/12		H03B	3 5/12 A		A		
H 0 3 K	17/95		H03K 1	H 0 3 K 17/95		M		
			審査請求	未請求	請求項の数3	OL	(全 5 頁)	
(21)出願番号		特願平10-19433	(71)出願人					
				株式会社	土山武			
(22)出願日		平成10年(1998) 1月30日		東京都沿	6谷区茂谷2丁	目12番19)号	
			(72)発明者	古島 広	太明			
				東京都設	收谷区改谷2丁	目12番19	号 山武八	
				ネウエル	レ株式会社内			
			(72)発明者	川井	4 —			
				東京都沿	收谷区按谷2丁I	目12番19	3号 山武ハ	
				ネウエバ	レ株式会社内			
			(74)代理人	弁理士	長門 侃二	外1名	;)	

(54) 【発明の名称】 高周波発振型近接スイッチ装置

(57)【要約】

【課題】 LCタンク回路を発振駆動するトランジスタ回路のバイアス電流を適正化して低消費電流化を図った 高周波発振型近接スイッチ装置を提供する。

【解決手段】 検出コイルとコンデンサとからなるLCタンク回路を発振駆動するトランジスタ回路を備え、前記トランジスタ回路に対するバイアス電流の供給回路を、定電流源により駆動されるカレントミラー回路にて構成すると共に、該カレントミラー回路にその出力電流を制御する抵抗を介挿した構成とする。特に上記電流調整用の抵抗を、定電流源により駆動されるカレントミラー回路をなす一対のトランジスタに対して外付けにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 検出コイルとコンデンサとからなるLC タンク回路を発振駆動するトランジスタ回路を備えてなり、検出対象物と上記検出コイルとの間の電磁誘導作用による発振動作の変化から前記検出対象物の近接を非接触に検出する高周波発振型近接スイッチ装置であって、前記トランジスタ回路に対するバイアス電流の供給回路を、定電流源により駆動されるカレントミラー回路にて構成すると共に、該カレントミラー回路にその出力電流を制御する抵抗を介挿したことを特徴とする高周波発振 10型近接スイッチ装置。

【請求項2】 前記電流調整用の抵抗は、カレントミラー回路をなす一対のトランジスタに対して外付けされることを特徴とする請求項1に記載の高周波発振型近接スイッチ装置。

【請求項3】 前記バイアス電流は、LCタンク回路を発振駆動するトランジスタのコレクタ・サブストレート間容量の充放電に用いられるものである請求項1に記載の高周波発振型近接スイッチ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、LCタンク回路を 発振駆動するトランジスタ回路に対するバイアス電流を 適正化することができ、無駄な電流を抑えて低消費電流 化を図った高周波発振型近接スイッチ装置に関する。

[0002]

【関連する背景技術】検出部に高周波発振回路の一部をなす検出コイルを備えた高周波発振型近接スイッチ(電子スイッチ装置)は、検出対象物(磁性体)との間の電磁誘導作用により検出コイルのインダクタンスや損失が変化し、これに伴って高周波発振回路における発振振幅や発振周波数が変化することを利用して検出対象物の近接を検出するもので、検出感度が高く応答速度が速い等の優れた特徴を有している。

【0003】一対の電源線を信号線と共用した2線式の高周波発振型近接スイッチは、例えば図3にその概略的な構成を示すように、高周波発振回路1、積分回路2、比較回路3、信号処理回路4、そして定電圧源5からなるセンサ回路部6と、このセンサ回路部6からの出力を受けてLED7aを点灯駆動する表示回路7.および一対の電源線La,Lb間に介装された出力回路8とを備えてなる。このような構成の近接スイッチは、上記一対の電源線La,Lbを、負荷9を介してマイクロプロセッサ等からなる監視装置10の内部電源Voutに接続され、該内部電源Voutから電源供給されて作動する。

振振幅は比較回路3にて所定の閾値電圧と比較され、これによって検出対象物(磁性体)の前記コイル1aへの近接に伴う発振振幅の低下が検出される。信号処理回路4はこのようにして検出された検出対象物の近接を該近接スイッチの設定状態に応じて出力する。尚、前記定電圧源5は所定の内部基準電圧に基づいて前記一対の電源線La,Lbを介して外部電源より供給される電源電圧Vccから上記各回路1,2,3,4をそれぞれ駆動する駆動電圧Vdrvを生成する。

【0005】しかして表示回路7は、例えば検出対象物の近接が検出されたときにLED7aを点灯駆動する。またバイポーラ・トランジスタ等からなる出力回路8は、例えば常時は非導通状態にあり、上記LED7aの点灯に関連して(検出対象物の近接が検出されたときに)導通駆動されて前記一対の電源線La,Lb間の電圧Vccを変化させる。このような電源線La,Lb間の電圧Vccの変化によって前記負荷9が作動し、監視装置10は該負荷9の作動状態から前記近接スイッチによる検出対象物の近接を検出することになる。

20 [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところでコイル1aとコンデンサ1bとからなるLCタンク回路を備えた高周波発振回路1は、例えば図4に示すように定電流源11から一定電流Irefを受けて動作してLCタンク回路を発振駆動する一対のnpnトランジスタQ1、Q2からなる第1のカレントミラー回路12と、上記トランジスタQ2の出力電流を受けて動作して第1のカレントミラー回路12に対して正帰還作用を呈する一対のpnpトランジスタQ3、Q4からなる第2のカレントミラー回路13とにより構成される。ちなみに上記定電流源11は、LCタンク回路を発振駆動する発振用のトランジスタQ1の基体をなすサブストレートとそのコレクタとの間の容量を充放電するバイアス電流Ibを供給する役割も担っ

【0007】一方、この種の高周波発振回路1における 発振周波数は、検出対象物やその近接検出距離等の仕様 に応じて設定され、一般的に上記発振周波数は数KHz と低いものから、数MHzと高いものまで様々である。 尚、検出対象物がアルミ粉等の金属粉や近接検出距離が 短い場合には、発振周波数は比較的低く設定される。ち なみに上記バイアス電流Ibは、上記発振周波数高いほ ど多く必要とする。

【0008】しかして従来の高周波発振回路1においては、特にこれをIC化するような場合には、上述した発振周波数が高く設定されることを見込んで前記定電流源11から供給されるバイアス電流Ibを大きく設定している。この為、低い周波数で発振動作させる場合、余分なバイアス電流Ibを流していることになることが否めない。この為、無駄な電流消費が生じて、その低消費電流化の妨げの要因となっている。

【0009】本発明はこのような事情を考慮してなされ たもので、その目的は、無駄な電流消費を防いで低消費 電流化を図るに好適な発振回路を備えた髙周波発振型近 接スイッチ装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する べく本発明に係る高周波発振型近接スイッチ装置は、検 出コイルとコンデンサとからなるLCタンク回路を発振 駆動するトランジスタ回路を備えてたものであって、特 に前記トランジスタ回路に対するバイアス電流の供給回 路を、定電流源により駆動されるカレントミラー回路に て構成すると共に、該カレントミラー回路にその出力電 流を制御する抵抗を介挿した構成としたことを特徴とし ている。

【0011】更に本発明の好ましい態様として請求項2 に記載するように、前記電流調整用の抵抗を、前記定電 流源により駆動されるカレントミラー回路をなす一対の トランジスタに対して外付けするようにしたことを特徴 としている。そして請求項3に記載するように、上記バ イアス電流により前記LCタンク回路を発振駆動するト ランジスタのコレクタ・サブストレート間容量を充放電 させることを特徴としている。

【0012】即ち、本発明はLCタンク回路を発振駆動 するトランジスタ回路に対して、定電流源により駆動さ れるカレントミラー回路を介してバイアス電流を供給す るようにし、該カレントミラー回路の出力電流(バイア ス電流)を抵抗により調整可能としたことを特徴として いる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態に係る 高周波発振型近接スイッチ装置の、特に髙周波発振回路 について図1を参照して説明する。尚、図1において は、図4に示した従来一般的な髙周波発振回路と同一部 分には同一符号を付して示してある。この高周波発振回 路が特徴とするところは、LCタンク回路を駆動する第 1のカレントミラー回路 12に対してバイアス電流 Ib を供給するバイアス電流供給回路を、一対のpnpトラ ンジスタQ5,Q6とからなり、定電流源14により駆動 される第3のカレントミラー回路15として実現し、上 記定電流源14の出力電流Irefを電流増幅して出力す ると共に、該第3のカレントミラー回路15に組み込ん だ抵抗Rbによりその出力電流(バイアス電流Ib)を調 整可能に構成したことを特徴としている。

【OO14】即ち、一定の電流 I refを出力する定電流 源14は、第3のカレントミラー回路15のダイオード 接続されたトランジスタO5のコレクタに接続され、該 カレントミラー回路 1 5を一定電流で駆動するようにな っている。そしてカレントミラー回路15は、トランジ スタQ5にベースを共通接続したトランジスタQ6を介し て、上記駆動電流に見合う電流を前記第1のカレントミ 50 スタQ6側の抵抗Rb2を外付けとして前記バイアス電流

ラー回路12の、特にトランジスタQ1に対するバイア ス電流Ibとして出力するものとなっている。また前記 トランジスタ〇5のエミッタには、該カレントミラー回 路15の動作条件を調整してトランジスタQ6からの出 力電流、ひいては前記第1のカレントミラー回路12に 対するバイアス電流 I bを調整する為の抵抗 R bが直列に 介挿されている。特にこの抵抗Rbは、例えば前述した 第1および第2のカレントミラー回路12,13と共に 集積一体化される第3のカレントミラー回路15に対し 10 て、所謂外付けの回路素子として組み込まれるようにな っている。

【0015】このように定電流源14からの電流 I ref を、一旦、第3のカレントミラー回路15により受け、 この第3のカレントミラー回路15からの出力電流によ りLCタンク回路を発振駆動する第1のカレントミラー 回路12に供給するように構成された髙周波発振回路に よれば、定電流源14が出力する電流Irefを一定に保 ったまま、第3のカレントミラー回路15に組み込まれ た抵抗RbによってトランジスタQ1に対するバイアス電 流Ibを容易に調整することが可能となる。特に外付け する抵抗Rbの抵抗値を選定するだけで、上記バイアス 電流lbを設定することができる。

【0016】従って上記構成のバイアス電流供給回路を 備えた髙周波発振回路であれば、その主体部をなすカレ ントミラー回路12,13等を集積回路化(IC化)し たとしても、発振周波数の仕様に応じて前記抵抗Rbの 値を異ならせることだけで簡易に前記バイアス電流Ib を調整することが可能となる。換言すれば、従来のよう に発振周波数が高く設定されることを見込んでトランジ スタQ1に対するバイアス電流 I bを大きく設定しておく 必要がなくなり、発振周波数に応じた適正なバイアス電 流Ibを設定することが可能となる。この結果、発振周 波数を低く設定する場合であっても、LCタンク回路を 駆動するトランジスタ 01に対して過剰なバイアス電流 Ibを供給することがなくなり、電流の無駄を省いて低 消費電流化を図ることが可能となる。

【0017】また上述したように簡易にバイアス電流 I bを調整し、LCタンク回路を駆動するトランジスタQ1 のコレクタ・サブストレート間の容量を充放電するに必 40 要な最低限のバイアス電流 I bだけを流すことが可能な ので、例えばIC化される髙周波発振回路を、上記バイ アス電流!bを異ならせて複数種類準備しておき、これ らの髙周波発振回路(IC)を発振周波数に応じて選択 的に用いる等の煩わしさをなくすこともできる等の効果 も奏せられる。

【0018】尚、本発明は上述した実施形態に限定され るものではない。例えば図2に示すように第3のカレン トミラー回路 1 5 を構成するトランジスタ Q5, Q6の各 エミッタにそれぞれ抵抗Rbl, Rb2を介挿し、トランジ

Ibを調節し得るようにしても良い。この場合、上記抵 抗Rbl, Rb2の双方を外付けとすることも勿論可能であ る。またここでは2線式の近接スイッチに組み込む場合 について説明したが、電源線と信号線とを別個に備える 高周波発振型近接スイッチ装置に対しても同様に適用可 能なことは言うまでもなく、またディスクリート回路部 品(素子)を用いて実現する場合にも適用可能なことは 当然である。その他、本発明はその要旨を逸脱しない範 囲で種々変形して実施することができる。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、L Cタンク回路を発振駆動するトランジスタ回路に対して バイアス電流を供給する電流供給回路を、定電流源によ って駆動されるカレントミラー回路により構成し、該カ レントミラー回路に組み込まれる抵抗を用いてその動作 を調整して上記バイアス電流を調整し得るようにしてい るので、発振周波数に応じた最適なバイアス電流を簡易 に設定して低消費電流化を図ることができる。

【0020】特にバイアス電流調整用の抵抗を抵抗を外 付けとすることにより、その抵抗値調整によるバイアス 20 15 第3のカレントミラー回路 電流の設定を簡易に行わしめる等の実用上多大なる効果

が奏せられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る髙周波発振型近接ス イッチ装置の特徴部分を示す高周波発振回路の概略構成 を示す図。

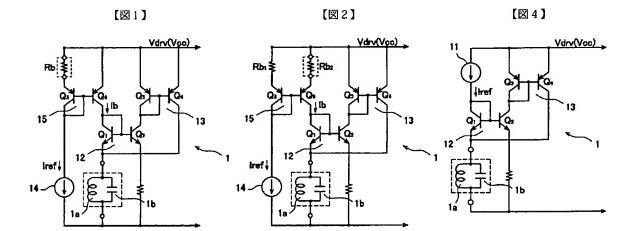
【図2】本発明に係る髙周波発振回路の変形例を示す概 略構成図。

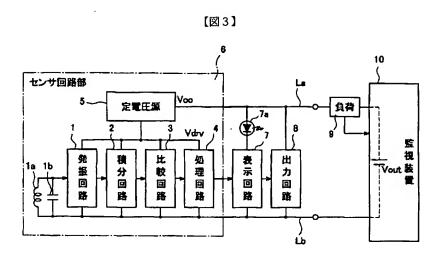
【図3】2線式の髙周波発振型近接スイッチ装置の全体 を示す概略構成図。

10 【図4】従来の一般的な髙周波発振回路の構成例を示す

【符号の説明】

- 1 髙周波発振回路
- 1a コイル
- 1 b コンデンサ
- 11 定電流源
- 12 第1のカレントミラー回路
- 13 第2のカレントミラー回路
- 14 定電流源
- - Rb バイアス電流調整用の抵抗





* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] It comes to have the transistor circuit which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit which consists of a sensing coil and a capacitor. It is high frequency oscillation mold proximity switch equipment which detects contiguity of said detection object to non-contact from change of the oscillation actuation by the electromagnetic-induction operation between a detection object and the above-mentioned sensing coil. High frequency oscillation mold proximity switch equipment characterized by inserting in this current Miller circuit the resistance which controls the output current while constituting the supply circuit of the bias current over said transistor circuit from current Miller circuit driven according to a constant current source.

[Claim 2] The resistance for said current adjustment is high frequency oscillation mold proximity switch equipment according to claim 1 characterized by carrying out external to the transistor of the pair which makes current Miller circuit.

[Claim 3] Said bias current is high frequency oscillation mold proximity switch equipment according to claim 1 which is what is used for the charge and discharge of the capacity between collector substrates of the transistor which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention can rationalize the bias current over the transistor circuit which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit, and relates to the high frequency oscillation mold proximity switch equipment which suppressed the useless current and attained low consumed-electric-current-ization.

[0002]

[A related background technique] The high-frequency oscillation mold proximity switch (electronic switch equipment) which equipped the detecting element with the sensing coil which makes a part of high frequency oscillator circuit detects contiguity of a detection object using the inductance of a sensing coil and loss changing with the electromagnetic-induction operations between detection objects (magnetic substance), and the oscillation amplitude and the oscillation frequency in a high-frequency oscillator circuit changing in connection with this, and detection sensitivity has the description which was [be / a speed of response / highly quick] excellent.

[0003] The high frequency oscillation mold proximity switch of the two-wire system which shared the power-source line of a pair with the signal line comes to have the output circuit 8 infixed between the power-source line La of the display circuit 7 which carries out the lighting drive of the LED7a in response to the output from the sensor circuit section 6 which consists of the high frequency oscillator circuit 1, an integrating circuit 2, a comparator circuit 3, a digital disposal circuit 4, and a source 5 of a constant voltage as that rough configuration is shown in drawing 3, and this sensor circuit section 6, and a pair, and Lb. It connects with the internal electrical power source Vout of the supervisory equipment 10 which consists of a microprocessor etc. through a load 9, and from this internal electrical power source Vout, current supply of the proximity switch of such a configuration is carried out, and it operates the power-source lines La and Lb of the above-mentioned pair.

[0004] That is, the oscillation amplitude is detected because the high frequency oscillator circuit 1 is equipped with coil (sensing coil) 1a and capacitor 1b which make LC tank circuit, and carries out oscillation actuation on a predetermined frequency and an integrating circuit 2 carries out integral processing (smoothing) of the output of an oscillator circuit 1. And the oscillation amplitude detected as an integral electrical potential difference is compared with predetermined threshold voltage in a comparator circuit 3, and the fall of the oscillation amplitude accompanying the contiguity to said coil 1a of a detection object (magnetic substance) is detected by this. A digital disposal circuit 4 outputs contiguity of the detection object detected by doing in this way according to the established state of this proximity switch. In addition, said source 5 of a constant voltage generates the driver voltage Vdrv which drives each above-mentioned circuits 1, 2, 3, and 4, respectively from the supply voltage Vcc supplied from an external power through the power-source lines La and Lb of said pair based on a predetermined internal reference electrical potential difference.

[0005] A deer is carried out, and a display circuit 7 carries out the lighting drive of the LED7a, when contiguity of for example, a detection object is detected. Moreover, the output circuit 8 which consists of

a bipolar transistor etc. is in non-switch-on, and in relation to lighting of the above-mentioned LED7a, a flow drive is carried out and it always changes the power-source line La of said pair, and the electrical potential difference Vcc between Lb(s) (when contiguity of a detection object is detected). Said load 9 will operate by change of such a power-source line La and the electrical potential difference Vcc between Lb(s), and supervisory equipment 10 will detect contiguity of the detection object by said proximity switch from the operating state of this load 9. [0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the way, the RF oscillator circuit 1 equipped with LC tank circuit which consists of coil 1a and capacitor 1b For example, 1st current Miller circuit 12 which consists of npn transistors Q1 and Q2 of the pair which operates in response to the fixed current Iref from a constant current source 11, and carries out the oscillation drive of the LC tank circuit as shown in drawing 4, It is constituted by 2nd current Miller circuit 13 which consists of pnp transistors Q3 and Q4 of the pair which operates in response to the output current of the above-mentioned transistor O2, and presents a positive feedback operation to 1st current Miller circuit 12. Incidentally the above-mentioned constant current source 11 also bears the role which supplies the bias current Ib which carries out the charge and discharge of the capacity between the substrate which makes the base of the transistor O1 for an oscillation which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit, and its collector. [0007] On the other hand, the oscillation frequency in this kind of RF oscillator circuit 1 is set up according to specifications, such as a detection object and its contiguity detection distance, and, generally its above-mentioned oscillation frequency is various from several kHz and a low thing to several MHz and a high thing. In addition, when a detection object has short metal powders and contiguity detection distance, such as aluminum powder, an oscillation frequency is set up comparatively low. incidentally -- the above-mentioned bias current Ib -- the above-mentioned oscillation frequency -- it needs so mostly that it is high.

[0008] In carrying out a deer and IC-izing this especially in the conventional RF oscillator circuit 1, it has set up greatly the bias current Ib which counts upon the oscillation frequency mentioned above being set up highly, and is supplied from said constant current source 11. When carrying out oscillation actuation on a low frequency for this reason, it cannot deny that the excessive bias current Ib will be passed. For this reason, useless current consumption arises and it has become the factor of the hindrance of that reduction in the consumed electric current.

[0009] This invention was made in consideration of such a situation, and the purpose is in offering high frequency oscillation mold proximity switch equipment equipped with the suitable oscillator circuit preventing useless current consumption and attaining low consumed-electric-current-ization.
[0010]

[Means for Solving the Problem] It is characterized by to consider the high-frequency oscillation mold proximity switch equipment applied to this invention in order the purpose mentioned above as the configuration which inserted in this current Miller circuit the resistance which controls the output current while it was equipped with the transistor circuit which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit which consists of a sensing coil and a capacitor and constituted the supply circuit of the bias current especially over said transistor circuit from current Miller circuit driven according to a constant current source.

[0011] Furthermore, it is characterized by carrying out external to the transistor of the pair which makes the current Miller circuit which drives the resistance for said current adjustment according to said constant current source so that it may indicate to claim 2 as a desirable mode of this invention. And it is characterized by carrying out the charge and discharge of the capacity between collector substrates of the transistor which carries out the oscillation drive of said LC tank circuit according to the abovementioned bias current so that it may indicate to claim 3.

[0012] That is, it is characterized by for this invention having supplied the bias current through the current Miller circuit which drives LC tank circuit according to a constant current source to the transistor circuit which carries out an oscillation drive, and enabling adjustment of the output current (bias current) of this current Miller circuit by resistance.

[0013]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, it is high frequency oscillation mold proximity switch equipment concerning 1 operation gestalt of this invention, especially a high frequency oscillator circuit is explained with reference to drawing 1. In addition, the same sign is given to the same part as the conventionally general RF oscillator circuit shown in drawing 4, and drawing 1 is shown. The place by which this RF oscillator circuit is characterized the bias current supply circuit which supplies a bias current Ib to 1st current Miller circuit 12 which drives LC tank circuit While it consists of pnp transistors Q5 and Q6 of a pair, and realizing as 3rd current Miller circuit 15 driven according to a constant current source 14, carrying out current amplification of the output current Iref of the abovementioned constant current source 14 and outputting it this -- it is characterized by constituting possible [adjustment of the output current (bias current Ib)] by the resistance Rb included in 3rd current Miller circuit 15.

[0014] That is, it connects with the collector of a transistor Q5 with which diode connection of 3rd current Miller circuit 15 was made, and the constant current source 14 which outputs the fixed current Iref drives this current Miller circuit 15 with a fixed current. And current Miller circuit 15 is outputting the current corresponding to the above-mentioned drive current to the transistor Q5 through the transistor Q6 which made common connection of the base as a bias current Ib especially over the transistor Q1 of said 1st current Miller circuit 12. Moreover, the resistance Rb for adjusting the operating condition of this current Miller circuit 15 to the emitter of said transistor Q5, and adjusting the output current from a transistor Q6, as a result the bias current Ib over said 1st current Miller circuit 12 to it is inserted in the serial. This resistance Rb is especially incorporated as the so-called external circuit element to 3rd current Miller circuit 15 by which accumulation unification is carried out with 1st and 2nd current Miller circuits 12 and 13 mentioned above.

[0015] Thus, 3rd current Miller circuit 15 once receives the current Iref from a constant current source 14. According to the RF oscillator circuit constituted so that 1st current Miller circuit 12 which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit according to the output current from this 3rd current Miller circuit 15 might be supplied It becomes possible to adjust easily the bias current Ib over a transistor Q1 by the resistance Rb included in 3rd current Miller circuit 15, keeping constant the current Iref which a constant current source 14 outputs. The above-mentioned bias current Ib can be set up only by selecting the resistance of the resistance Rb which carries out especially external. [0016] Therefore, if it is the RF oscillator circuit equipped with the bias current supply circuit of the above-mentioned configuration, even if it will integrated-circuit-ize current Miller circuit 12 and 13 grades which make the subject section (IC-izing), it becomes possible to adjust said bias current Ib simply only by changing the value of said resistance Rb according to the specification of an oscillation frequency. If it puts in another way, it will become possible to count upon an oscillation frequency being highly set up like before, and for it to become unnecessary to set up greatly the bias current Ib over a transistor Q1, and to set up the proper bias current Ib according to an oscillation frequency. Consequently, even if it is the case where an oscillation frequency is set up low, supplying the superfluous bias current Ib to the transistor Q1 which drives LC tank circuit is lost, and it becomes possible to exclude the futility of a current and to attain low consumed-electric-current-ization. [0017] Moreover, since it is possible to pass only the minimum bias current Ib required to carry out the charge and discharge of the capacity between the collector substrates of the transistor Q1 which adjusts a bias current Ib simply as mentioned above, and drives LC tank circuit For example, the abovementioned bias current Ib is changed, two or more kinds of high frequency oscillator circuits IC-ized are prepared, and the effectiveness of being able to lose troublesomeness, such as using these high frequency oscillator circuits (IC) alternatively according to an oscillation frequency, is also done so. [0018] In addition, this invention is not limited to the operation gestalt mentioned above. For example, as shown in drawing 2, resistance Rb1 and Rb2 is inserted in each emitter of the transistors Q5 and Q6 which constitute 3rd current Miller circuit 15, respectively, and you may enable it to adjust said bias current Ib by making external resistance Rb2 by the side of a transistor Q6. In this case, of course, it is also possible to make external the both sides of the above-mentioned resistance Rb1 and Rb2. Moreover,

to say nothing of the ability to apply a power-source line and a signal line similarly to the high frequency oscillation mold proximity switch equipment which it has separately, although the case where it included in the proximity switch of two-wire system here was explained, when realizing [and] using discrete circuit components (component), naturally, it can apply. In addition, in the range which does not deviate from the summary, this invention can deform variously and can be carried out. [0019]

[Effect of the Invention] Since the current Miller circuit driven according to a constant current source constitutes the current-supply circuit which supplies a bias current to the transistor circuit which carries out the oscillation drive of the LC tank circuit, the actuation is adjusted using the resistance included in this current Miller circuit and it enables it to adjust the above-mentioned bias current according to this invention as explained above, the optimal bias current according to an oscillation frequency can be set up simply, and low consumed-electric-current-ization can be planned.

[0020] By making resistance external for the resistance for bias current adjustment especially, practically great effectiveness, such as making the bias current by the resistance adjustment set up simply etc., is done so.

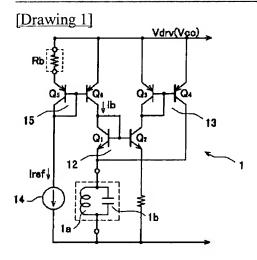
[Translation done.]

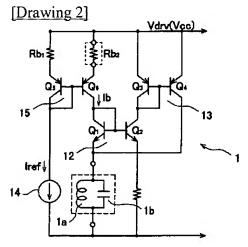
* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

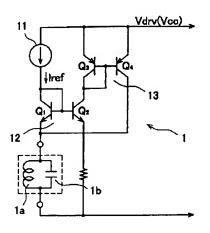
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

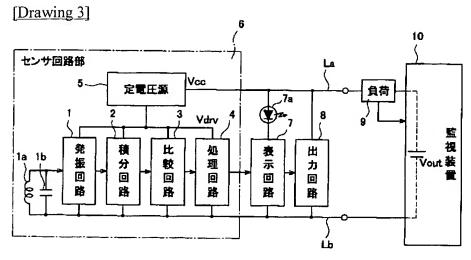
DRAWINGS





[Drawing 4]





[Translation done.]

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

EADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.